

## Пример гетероструктуры для НЕМТ

<b>Метод изготовления</b>	<b>NH<sub>3</sub>-MBE</b>												
<b>Диаметр</b>	<b>50,8 мм</b>												
<b>Тип подложки</b>	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0001), 6H-SiC</b>												
<b>Пример для структуры слоёв</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Al<sub>0.33</sub>Ga<sub>0.67</sub>N</td> <td style="text-align: center;">10÷28 нм</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AlN-spacer</td> <td style="text-align: center;">2 нм</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GaN</td> <td style="text-align: center;">2000 нм</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">grad Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N</td> <td style="text-align: center;">210 нм</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AlN</td> <td style="text-align: center;">500 нм</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Substrate</td> <td></td> </tr> </table>	Al <sub>0.33</sub> Ga <sub>0.67</sub> N	10÷28 нм	AlN-spacer	2 нм	GaN	2000 нм	grad Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> N	210 нм	AlN	500 нм	Substrate	
Al <sub>0.33</sub> Ga <sub>0.67</sub> N	10÷28 нм												
AlN-spacer	2 нм												
GaN	2000 нм												
grad Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> N	210 нм												
AlN	500 нм												
Substrate													
<b>Концентрация носителей</b>	<b>1,25·10<sup>13</sup> см<sup>-2</sup></b>												
<b>Подвижность носителей</b>	<b>≥1600 см<sup>2</sup>/В·с</b>												
<b>Слоевое сопротивление</b>	<b>350 Ом/□</b>												

## Пример готовой топологии для НЕМТ

